

第1回エレクトロニクス基盤技術研究部門シンポジウム

次世代エレクトロニクスを支える 新材料デバイスと検査技術

2026年12月18日(金) 13:00-17:20

産業技術総合研究所 臨海副都心センター
別館11階会議室 (東京都江東区青海2-4-7)

https://www.aist.go.jp/aist_j/information/research_bases/waterfront/

シンポジウム
参加費
無料



PROGRAM

- 13:00-13:10 開会の辞 安田 哲二 (産業技術総合研究所 執行役員/エレクトロニクス・製造領域 領域長)
- 13:10-13:20 挨拶 小谷 泰久 (光産業技術振興協会 副理事長/専務理事)
- 13:20-13:35 部門紹介 佐藤 正健 (エレクトロニクス基盤技術研究部門 研究部門長)
- 招待講演
13:35-14:20 光や電子を活用した半導体の検査計測ニーズ・最新装置
圓山 百代 ((株)日立製作所)
- 14:20-14:40 超高速半導体検査装置に向けた平面型マルチ電子ビーム源の開発
村上 勝久 (エレクトロニクス基盤技術研究部門)
- 14:40-15:00 異種材料集積光デバイスの一括特性評価に向けたEOイメージング技術の開発
須波 圭史 (エレクトロニクス基盤技術研究部門)
- 15:00-15:45 コーヒーブレイク&ポスターセッション★
- 招待講演
15:45-16:30 トポロジカル磁性体の新奇性を用いた革新的半導体デバイスの開発と社会実装
佐藤 太紀 (TopoLogic(株))
- 16:30-16:50 エレクトロニクス基盤技術研究部門における超伝導材料開発と応用への道筋
萩野 拓 (エレクトロニクス基盤技術研究部門)
- 16:50-17:10 超伝導ジョセフソンプラズマエミッターを基盤とした次世代テラヘルツ技術の創出
辻本 学 (エレクトロニクス基盤技術研究部門)
- 17:10-17:20 閉会挨拶 佐藤 正健 (エレクトロニクス基盤技術研究部門 研究部門長)
- 17:45-19:45 意見交換会★★ 事前登録制

参加申込



締切: 2026年12月8日(火)
定員: 140名

<https://forms.cloud.microsoft/r/dRS7GsuavC>

★ポスター発表 15:00-15:45
各研究グループの紹介と
研究内容を展示(全14件)

★★意見交換会 17:45-19:45
同じフロアで開催(定員50名/事前登録制)
参加費: 3,000円
(当日受付にてお支払いください)

主催: 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 エレクトロニクス基盤技術研究部門
共催: 一般社団法人 光産業技術振興協会

連絡先: 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 エレクトロニクス基盤技術研究部門 シンポジウム担当
M-cetri-symposium2026-ml@aist.go.jp

 産総研
ともに挑む。つぎを創る。